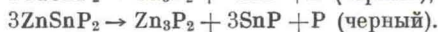
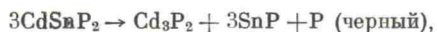


Данные о синтезе GeP из элементов при нормальном давлении приведены в работе (7), где получены две фазы GeP<sub>1,01</sub> и GeP<sub>0,73</sub>, интенсивности и межплоскостные расстояния которых не совпадают с результатами, полученными в настоящей работе (табл. 1). Аналогичный синтез GeP из элементов, но при высоких давлениях (до 40 кбар) и температурах, проведен в работе (8), где получены данные для нескольких форм предполагаемого соединения состава GeP, не совпадающие с данными, приведенными в табл. 1.

При давлении выше 70 кбар и температурах от 500 до 1200° характер разложения CdGeP<sub>2</sub> изменяется. На дебаеграммах вещества, полученного при указанных выше параметрах, отчетливо видны линии металлического кадмия, что, возможно, указывает на разложение, аналогичное упомянутому разложению для CdSiP<sub>2</sub>. Межплоскостные расстояния и интенсивности GeP<sub>2</sub> приведены в табл. 1. Литературные данные о синтезе GeP<sub>2</sub> при атмосферном давлении и в условиях высоких давлений и температур отсутствуют. Пикнометрически определенная плотность смеси (Cd + GeP<sub>2</sub>)  $\rho_{эф} = 5,6 \pm \pm 0,02$  г/см<sup>3</sup>, что соответствует относительному уменьшению удельного объема при разложении на 25%. Обратный синтез исходного соединения CdGeP<sub>2</sub> осуществляется нагреванием полученной при разложении смеси в вакууме при температуре 400° в течение одного часа.

Для CdSnP<sub>2</sub> и ZnSnP<sub>2</sub> при давлении выше 40 кбар и температуре 400—600° найдено однотипное разложение



При этом структура SnP соответствовала структуре типа NaCl с параметром  $a = 5,506 \pm 0,002$  Å (см. табл. 2).

Расчетное изменение удельных объемов  $\Delta V / V_0$  составляет 13% для CdSnP<sub>2</sub> и 11,9% для ZnSnP<sub>2</sub>, а относительные изменения объемов, полученные из пикнометрических измерений плотности смеси продуктов разложения, равны 13 и 12% соответственно.

Полученные рентгеновские данные несколько отличаются по интенсивности линий и параметрам элементарной ячейки от данных, приведенных в работе (8), в которой найдена кубическая фаза SnP при синтезе под давлением из смеси элементов Sn + P. Это отличие, возможно, связано с отклонением от стехиометрического состава. При нормальном давлении (9) SnP кристаллизуется в гексагональной структуре с параметрами элементарной ячейки  $a = 8,78$  Å;  $c = 5,98$  Å;  $z = 8$ , плотность, рассчитанная по рентгеновским данным, равна 4,98 г/см<sup>3</sup>.

Таблица 1

Межплоскостные расстояния  
и интенсивности линий

I	d	I	d
Для GeP			
о. сл.	3,868	с.	1,877
о. сл.	3,494	о. сл.	1,811
о. сл.	3,133	ср.	1,590
ср.	2,979	сл.	1,554
ср.	2,844	сл.	1,497
сл.	2,715	о. сл.	1,321
сл.	2,339	о. сл.	1,296
о. сл.	1,981	сл.	1,212
с. сл.	1,953	сл.	1,163
Для GeP <sub>2</sub>			
сл.	4,135	о. сл.	1,590
о. сл.	3,709	о. сл.	1,542
о. сл.	3,304	о. сл.	1,463
сл.	3,100	о. сл.	1,212
сл.	2,922	о. сл.	1,146
сл.	2,675	сл.	1,028
о. сл.	2,104	о. сл.	0,9753
о. сл.	1,998	о. сл.	0,9502
сл.	1,811	о. сл.	0,9352
о. сл.	1,765	о. сл.	0,8613
о. сл.	1,675	о. сл.	0,8471
о. сл.	1,648		
Для фазы SnP при 10—20 кбар			
ср.	3,591	с.	1,648
ср. сл.	3,428	сл.	1,480
сл.	2,922	ср.	1,427
ср.	2,436	сл.	1,352
ср.	2,276	сл.	1,331
сл.	2,006	сл.	1,273
с.	1,906		
сл.	1,791		
сл.	1,728		



При давлении 10—20 кбар и температуре 700° для CdSnP<sub>2</sub> имеет место, по-видимому, тот же самый тип разложения (на это указывает присутствие на дебаеграммах линий Cd<sub>3</sub>P и черного фосфора). Однако SnP в этой области давлений имеет другую кристаллическую структуру, не совпадающую с данными (9). Межплоскостные расстояния и интенсивности линий этой фазы приведены в табл. 1.

В интервале давлений от 20 до 40 кбар сосуществуют обе фазы SnP, на что указывает присутствие на дебаеграммах линий обеих фаз.

Таблица 2

Межплоскостные расстояния и интенсивности линий для фазы SnP со структурой типа NaCl

<i>I</i>	<i>d</i> <sub>измер</sub>	<i>hkl</i>	<i>d</i> <sub>вычисл</sub>	<i>I</i>	<i>d</i> <sub>измер</sub>	<i>hkl</i>	<i>d</i> <sub>вычисл</sub>
ср.	3,15	111	3,18	с.	1,12	422	1,12
с.	2,72	200	2,75	ср.	1,058	511/333	1,060
с.	1,93	220	1,95	с. ш.	0,969	440	0,973
с.	1,65	311	1,66	ср. с.	0,928	531	0,931
с.	1,58	222	1,59	о. с.	0,916	600/442	0,918
ср.	1,37	400	1,38	с. ш.	0,870	620	0,871
сл.	1,26	331	1,26	сл. ш.	0,839	533	0,840
с.	1,23	420	1,23	сл.	0,829	622	0,830
				сл. ш.	0,795	444	0,795

При давлении выше 60 кбар и температуре выше 600° на дебаеграммах CdSnP<sub>2</sub> так же, как и в случае CdGeP<sub>2</sub>, появляются линии металлического кадмия, интенсивность которых увеличивается с ростом давления. Однако линии, соответствующие кубической фазе SnP со структурой типа NaCl, присутствуют до давления 120 кбар.

Для ZnSnP<sub>2</sub> не обнаружено аналогичного появления металлического цинка во всем исследованном диапазоне давлений и температур. ZnGeP<sub>2</sub> при давлении до 120 кбар и температуре до 1500° и ZnSiP<sub>2</sub> при давлении до 90 кбар и температуре до 1500° не претерпевают никаких изменений.

Как видно из приведенных выше результатов, соединения CdSiP<sub>2</sub>, CdGeP<sub>2</sub>, CdSnP<sub>2</sub> и ZnSnP<sub>2</sub> в условиях высоких давлений и температур разлагаются аналогично соответствующим соединениям с мышьяком CdSnAs<sub>2</sub>, CdGeAs<sub>2</sub> и ZnSnAs<sub>2</sub> (2). Отличие состоит в характере разложения, а именно в выделении металлического кадмия в случае CdSiP<sub>2</sub>, CdGeP<sub>2</sub> и CdSnP<sub>2</sub>. Диаграммы (*T, P*) для двух последних соединений являются более сложными, чем для соответствующих арсенидов, и для окончательной интерпретации нуждаются в дополнительных данных об устойчивости соединений GeP, GeP<sub>2</sub>, SnP при высоких давлениях и температурах.

В заключение авторы выражают благодарность акад. Л. Ф. Верещагину за постоянное внимание и участие в обсуждении результатов, а также Н. В. Каляевой, А. С. Борщевскому, Ю. А. Валову, В. И. Соколовой и И. И. Тычине за помощь при выполнении работы.

Институт физики высоких давлений  
Академии наук СССР

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе  
Академии наук СССР

Поступило  
30 XII 1968

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> C. J. M. Rooymans, Investigations on Some Chalcogenides at Very High Pressures, Universiteit van Amsterdam, 1967. <sup>2</sup> A. R. Storm, A. Yayaraman, J. Phys. Chem. Solids, 29, 623 (1968). <sup>3</sup> T. Wadsten, Acta chem. scand., 21, 1374 (1967). <sup>4</sup> T. Wadsten, Acta chem. scand., 21, 593 (1967). <sup>5</sup> I. Osugi, R. Namikawa, Y. Tanaka, Rev. Phys. Chem. Japan, 36, 35 (1966). <sup>6</sup> A. S. Borshchevskii, N. A. Goryunova et al., Phys. Stat. Solidi, 21, 1, 9 (1967). <sup>7</sup> M. Zumbusch, Zs. anorg. u. allgem. Chem., 242, 237 (1939). <sup>8</sup> I. Osugi, J. Chem. Soc. Japan, Pure Chem. Sect., 89, № 8, 746 (1968). <sup>9</sup> G. Katz, J. A. Kohn, J. D. Broder, Acta crystallogr., 10, 607 (1957).